

Lösungen zu Kapitel 4:

Aufgabe 4.1: Rekombination in der c-Si-Solarzelle

- a) Die wichtigsten sind Störstellen-Rekombinationen (Fremdatome, Kristallbaufehler) sowie Oberflächen-Rekombinationen
- b) Dies ist der oberste Bereich der n^+ -Emitterschicht. Aufgrund der hohen Dotierung rekombinieren die erzeugten Löcher sehr schnell, so dass diese Schicht kaum einen Beitrag zum Photostrom liefert.
- c) $x_{\text{Abs}} = 140 \mu\text{m}$, $\tau_N = 7 \mu\text{s}$,
 $L_N = 156,5 \mu\text{m} > x_{\text{Abs}}$
Ja, das erzeugte Elektron wird voraussichtlich zum Photostrom beitragen.

Aufgabe 4.2: Absorptionswirkungsgrad einer c-Si-Zelle

- a) $x_E = 100 \mu\text{m}$
- b) $R = 28,61 \%$
 $E_R = 286,1 \text{ W/m}^2$
- c) $E_1 = 731,9 \text{ W/m}^2$
 $E_2 = 176,0 \text{ W/m}^2$
 $E_{\text{Abs}} = E_1 - E_2 = 537,9 \text{ W/m}^2$
- d) Durch die Verspiegelung auf der Rückseite verdoppelt sich praktisch die optische Zellenlänge:
 $E_1 = E(x=0) = E_0$
 $E_2 = E(x=2 \cdot d) = E_1 \cdot e^{-\alpha \cdot 2 \cdot d} = 60,8 \text{ W/m}^2$
 $E_{\text{Abs}} = E_1 - E_2 = 939,2 \text{ W/m}^2$
- e) $\eta_{\text{Abs}} = \frac{E_{\text{Abs}}}{E_0} = 93,22 \%$
 $S(\lambda) = \frac{q}{h \cdot c} \cdot \lambda \cdot \eta_{\text{Ext}}$
Hier: $\eta_{\text{Ext}} = \eta_{\text{Abs}} \Rightarrow S(\lambda) = \frac{1}{1,24 \mu\text{m}} \cdot 1 \mu\text{m} \cdot 93,22 \% = 75,18 \%$

Aufgabe 4.3: Eindioden-Ersatzschaltbild

- a) Siehe Abschnitt 4.5.2
- b) Serienwiderstand:
Widerstand der Kontaktfinger auf der Zelloberseite, Metall-Halbleiter-Übergangswiderstand, Ohmscher Widerstand im Halbleiter.

Parallelwiderstand:

Lokale Kurzschlüsse des pn-Übergangs, unzureichende Isolation an den Kanten der Solarzelle

- c) Siehe Abbildung 4.15 a)
Im Kurzschlusspunkt sinkt der Strom bei steigendem R_S , da an R_S eine steigende Spannung abfällt, hierdurch U_D ansteigt und der Diodenstrom stärker wird. Der Leerlaufpunkt ändert sich nicht, da hier kein Strom durch R_S fließt und somit auch keine Spannung an ihm abfällt.

d) Siehe Abbildung 4.15 b)

Im Leerlaufpunkt steigt bei fallendem R_p der Anteil des Photostroms, der durch R_p fließt. Für die Diode bleibt daher weniger Strom übrig, so dass U_D kleiner wird. Da im Leerlaufpunkt $U_D = U_L$ gilt, sinkt somit U_L bei fallendem R_p . Der Kurzschlusspunkt ist fast unabhängig von R_p , da in diesem Fall R_p und R_s parallel geschaltet sind und R_s typischerweise mehr als eine Größenordnung kleiner als R_p ist.

Aufgabe 4.4: Spektraler und theoretischer Wirkungsgrad

- Der spektrale Wirkungsgrad gibt an, welcher Teil der einfallenden Strahlungsleistung theoretisch mit einem Halbleiter des Bandabstands ΔW_G genutzt werden kann. Die **Transmissionsverluste** beschreiben den Teil des Spektrums, dessen Photonen zu energiearm sind, um die Bandlücke zu überwinden. Thermalisierung tritt dagegen bei Photonen auf, die energiereicher sind als die Bandlücke. In diesem Fall kann nur ein Teil der Energie für den Halbleiter genutzt werden, der Rest wird in Wärme umgewandelt.
- Der theoretische Wirkungsgrad berücksichtigt zusätzlich zwei Verlustursachen: Zum einen kann in einer Solarzelle nicht die volle Spannung $\Delta W_G/q$ genutzt werden. Außerdem führt die Verwendung eines pn-Übergangs dazu, dass der Füllfaktor immer kleiner als 100 % ist.
- Der theoretische Wirkungsgrad für c-Si-Zellen liegt bei 28,6 %. Die Weltrekordzelle aus Australien liegt mit ihrem gemessenen tatsächlichen Wirkungsgrad von 25 % schon nah an diesem Optimum.

Aufgabe 4.5: Spektraler Wirkungsgrad bei monochromatischem Licht

$$a) \quad N_{\text{Ph}} = \frac{W_{\text{Opt}}}{W_{\text{Ph}}} = \frac{P_{\text{Opt}} \cdot \Delta t}{h \cdot f} = \frac{E \cdot A \cdot \Delta t}{h \cdot c} = \frac{1000 \text{ W/m}^2 \cdot 10 \text{ cm}^2 \cdot 1 \text{ s}}{6,6 \cdot 10^{-34} \text{ W} \cdot \text{s}^2 \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = \underline{5,051 \cdot 10^{19}}$$

$$j_{\text{Max}} = \frac{\text{Ladung}}{\text{Zeit} \cdot \text{Fläche}} = \frac{N_{\text{Ph}} \cdot q}{\Delta t \cdot A_{\text{Zelle}}} = \frac{5,051 \cdot 10^{19} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}}{1 \text{ s} \cdot 10 \text{ cm}^2} = \underline{80,8 \text{ mA/cm}^2}$$

$$b) \quad \text{Sättigungsstromdichte: } j_s = K_s \cdot e^{-\frac{\Delta W_G}{k \cdot T}} = 40.000 \text{ A/cm}^2 \cdot e^{-\frac{1,12 \text{ eV}}{8,63 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K} \cdot 298,15 \text{ K}}} = 5 \text{ fA/cm}^2$$

$$\text{Leerlaufspannung: } U_L = U_T \cdot \ln \frac{I_K}{I_s} = U_T \cdot \ln \frac{j_{\text{Max}}}{j_s} = 26 \text{ mV} \cdot \ln \frac{80,8 \text{ mA/cm}^2}{5 \cdot 10^{-15} \text{ A/cm}^2} = \underline{791 \text{ mV}}$$

$$c) \quad \text{Mit Gleichung (4.18): } FF = \underline{85,9 \%}$$

$$d) \quad \text{Mit Gleichung (4.48): } \eta_T = \frac{U_L \cdot j_{\text{Max}} \cdot FF}{E} = \underline{54,9 \%}$$

$$e) \quad j'_{\text{Max}} = j_{\text{Max}} \cdot 1.000 = \underline{80,8 \text{ A/cm}^2}$$

$$U'_L = U_T \cdot \ln \frac{1.000 \cdot j_{\text{Max}}}{j_s} = U_L + U_T \cdot \ln 1.000 = 791 \text{ mV} + 26 \text{ mV} \cdot 6,908 = \underline{971 \text{ mV}}$$

$$FF' = 1 - \frac{1 + \ln\left(\frac{U'_L}{U_T} + 0,72\right)}{\frac{U'_L}{U_T} + 1} = \underline{87,9 \%}$$

$$\eta'_T = \frac{U'_L \cdot j'_{\text{Max}} \cdot FF'}{E'} = \underline{68,9 \%}$$